パワートランジスタ Power Transistor

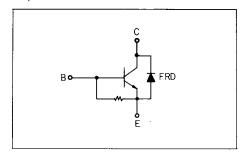
ET227



1000V 100A 960W 1

■等価回路図

Equivalent Circuit Schematic

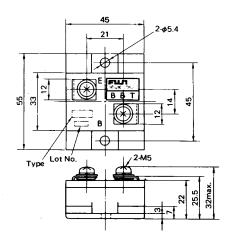


■定格と特性: Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格:Absolute Maximum Ratings

			•	
Items		Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース	間電圧	V _{CBO}	1000	V
コレクタ・エミッタ	間電圧	Vceo	1000	V
コレクタ・エミッタ	間電圧	VcEo(sus)	800	V
エミッタ・ベース	間電圧	VEBO	6	V
	DC	Ic	100	Α
コレクタ電流	1ms	l c	200	Α
	DC	-1c	100	Α
DC		Iв	40	Α
ベース電流	1ms	lв	80	A
コレクタ損失	one Transistor	Pc	960	W
コレクメ損大	two Transistor	Pc	_	W
接合部温	度	Tj	+150	°C
保 存 温	度	Tstg	$-40 \sim +125$	°C
重	#	m	145	g
絶縁 耐圧	AC.1min	Viso		V
締付けト	ルク	Mounting	25±5	kg ⋅ cm
רו עון מהא (ו	ルク	Terminals	M5:25±5	kg•cm

■外形寸法:Outline Drawings



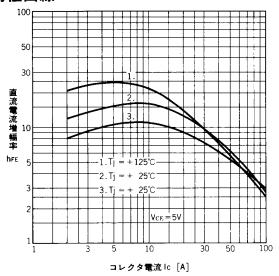
●電気的特性: Electrical Characteristics(Tj = 25°C)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Тур	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	I _{CBO} = 1mA	1000			V
コレクタ・エミッタ間電圧	VCEO	Iceo=1mA	1000			V
コレクタ・エミッタ間電圧	VcEo(sus)	Ic=2A	800			V
	VCEX(SUS)	$I_{C} = 100A$, $-I_{B} = 3A$	1000			V
エミッタ・ベース間電圧	VEBO	IEBO=400mA	6			V
コレクタしゃ断電流	Сво	VcB0=1000 V			1	mΑ
エミッタしゃ断電流	ГЕВО	V _{EBO} = 6 V			400	mΑ
コレクタ・エミッタ間電圧	- Vce	-1c = 100A		1.5	1.7	V
直流電流増幅率	hre	$I_C = 60A$, $V_{CE} = 5V$	4			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	VCE(Sat)	Ic=60A. IB=30A			1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	VBE(Sat)	10-00A, 18=30A			2.0	V
*)	ton				_	μS
スイッチング時間	t stg				_	μS
	tr				_	μS

●熟的特性: Thermal Characteristics

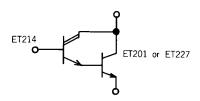
	Items		Symbols	Test Conditions	Min	Тур	Max	Units
熱	抵	抗	Rth(j-c)	Transistor			0.13	°C/W
熱	抵	抗	Rth(j-c)	Diode			0.6	°C/W
熱	抵	抗	Rth(c-f)	with Thermal Compound		0.05		°C/W

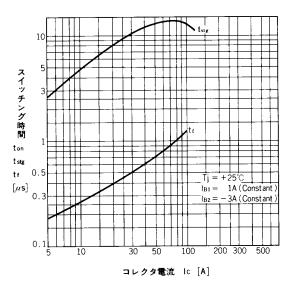
■特性曲線:Characteristics



直流電流増幅率-コレクタ電流特性

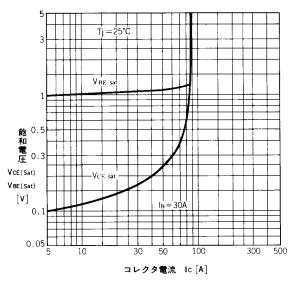
DC Current Gain





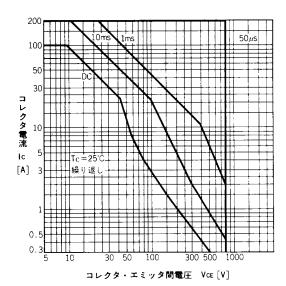
スイッチング時間-コレクタ電流特性

Switching Time



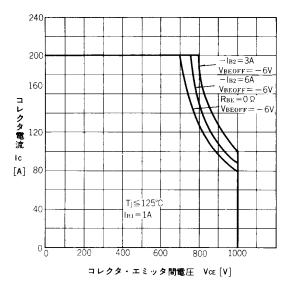
飽和電圧一コレクタ電流特性

Base and Collector Saturation Voltage

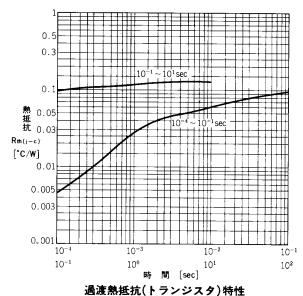


安全動作領域特性

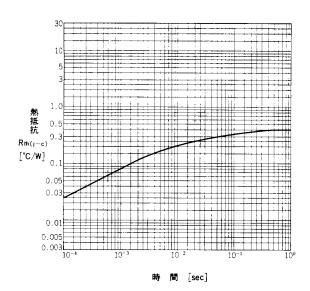
Safe Operating Area



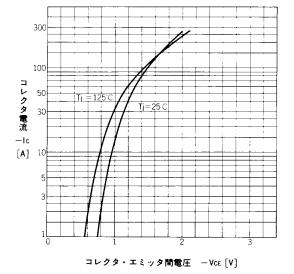
逆バイアス安全動作領域特性 Reverse Bias Safe Operating Area



Transient Thermal Resistance(Transistor)



過渡熟抵抗(ダイオード)特性 Transient Thermal Resistance(Diode)



高速ダイオードの電圧降下特性 Fast Recovery Diode's Voltage